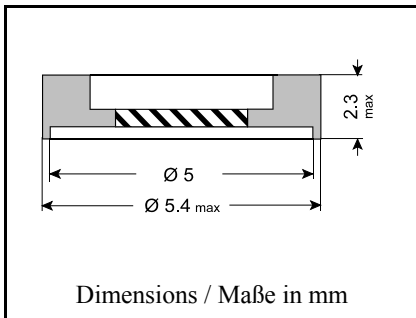


**Silicon Rectifier Cells
with polysiloxan passivation**

**Silizium-Gleichrichterzellen
mit Polysiloxan-Passivierung**



Nominal current – Nennstrom	3 A
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	50...1000 V
Weight approx. – Gewicht ca.	0.3 g
Standard packaging bulk Standard Lieferform lose	

Maximum ratings and Characteristics

Kenn- und Grenzwerte

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V_{RRM} [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung V_{RSM} [V]
AG 3A	50	80
AG 3B	100	130
AG 3D	200	250
AG 3G	400	450
AG 3J	600	700
AG 3K	800	1000
AG 3M	1000	1300

Max. average forward rectified current, R-load Dauergrenzstrom in Einwegschtung mit R-Last	$T_T = 100^\circ\text{C}$	I_{FAV}	3 A ¹⁾
Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom	$f > 15\text{ Hz}$	I_{FRM}	30 A ¹⁾
Peak forward surge current, 50 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwellle	$T_A = 25^\circ\text{C}$	I_{FSM}	150 A
Rating for fusing – Grenzlastintegral, $t < 10\text{ ms}$	$T_A = 25^\circ\text{C}$	i^2t	110 A ² s
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_j T_s	– 50...+150°C – 50...+150°C
Forward voltage Durchlaßspannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 3\text{ A}$	V_F style="text-align: right;">< 1.2 V
Leakage current – Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$V_R = V_{RRM}$	I_R style="text-align: right;">< 10 µA

¹⁾ Max. temperature of the terminals $T_T = 100^\circ\text{C}$ – Max. Temperatur der Kontaktflächen $T_T = 100^\circ\text{C}$